

LN15XB60

600V 15A

特長

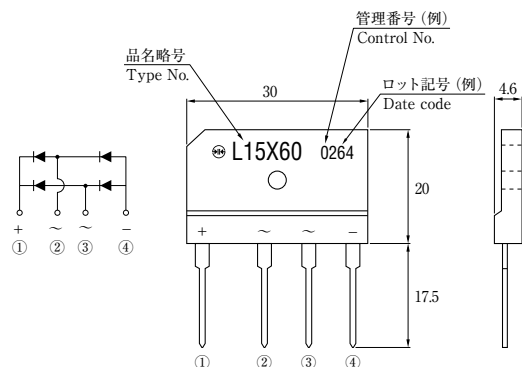
- 薄型 SIP パッケージ
- 低ノイズ
- 高放熱伝導性

Feature

- Thin-SIP
- Low Noise
- High Thermal Radiation

■外観図 OUTLINE

Package : 5S

Unit : mm
Weight : 7.1g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

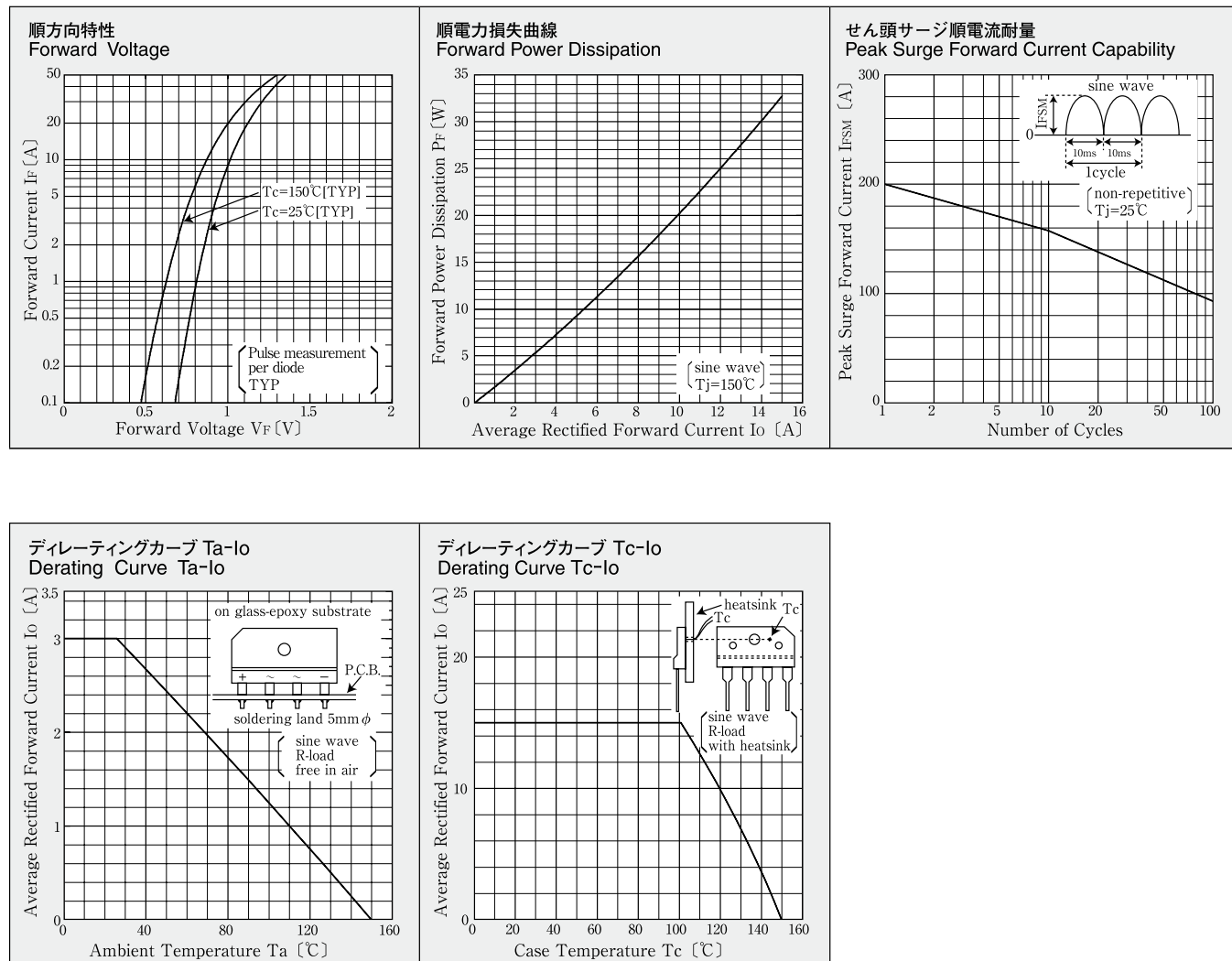
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	LN15XB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			- 55 ~ 150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink	$T_c = 100^\circ\text{C}$ 15	A
			フィンなし Without heatsink	$T_a = 25^\circ\text{C}$ 3	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		200	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$, 1 素子当たりの規格値 per diode		90	A^2s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V_{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: $0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$) (Recommended torque : $0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$)		0.8	$\text{N} \cdot \text{m}$

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 7.5 \text{ A}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 0.1 \text{ A}$, $I_R = 0.1 \text{ A}$, 1 素子当たりの規格値 per diode	MAX 5	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 1.5	$^\circ\text{C/W}$
	θ_{jl}	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 5	
	θ_{ja}	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 23	

特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.